트리스(2,4-디3급부틸페닐)포스피트의 합성에 미치는 몇가지 유기역기들의 영향

리상룡, 맹래원, 김영미

경애하는 최고령도자 김정은동지께서는 다음과 같이 말씀하시였다.

《전략수행기간 석탄가스화에 의한 탄소하나화학공업을 창설하고 갈탄을 리용하는 석 탄건류공정을 꾸리며 회망초를 출발원료로 하는 탄산소다공업을 완비하여 메라놀과 합성 연유. 합성수지를 비롯한 화학제품생산의 주체화를 높은 수준에서 실현하여야 합니다.》

선행연구[1, 2]들에서는 트리스(2,4-디3급부틸페닐)포스피트의 합성에 여러가지 유기 염기들을 리용하였다.

우리는 4종의 유기염기를 선택하고 그것이 트리스(2,4-디3급부틸페닐)포스피트의 합성에 미치는 영향을 고찰하였다.

실험 방법

2,4-디3급부틸페놀과 삼염화린으로부터 트리스(2,4-디3급부틸페닐)포스피트를 합성하는 반응식은 다음과 같다.

OH
$$R + PCl_{3} \stackrel{\triangle}{\longrightarrow} R - O-PCl_{2} + HCl$$

$$R + PCl_{3} \stackrel{\triangle}{\longrightarrow} R - O-PCl + 2 HCl$$

$$R + PCl_{3} \stackrel{\triangle}{\longrightarrow} R - O-PCl + 2 HCl$$

$$R + PCl_{3} \stackrel{\triangle}{\longrightarrow} R - O-PCl + 2 HCl$$

$$R + PCl_{3} \stackrel{\triangle}{\longrightarrow} R - O-PCl + 2 HCl$$

여기서 R는 3급부틸기이다.

온도계, 응축기, 방울깔때기가 설치된 3구플라스크에 1mol의 2,4-디3급부릴폐놀, 적당한 량의 유기염기를 넣고 교반하면서 60℃까지 온도를 올리였다. 다음 0.4mol의 삼염화린을 20min동안 적하하였다. 2,4-디3급부릴폐놀과 삼염화린과의 반응은 센 발열반응이므로 삼염화린을 천천히 적하하고 센 교반속도(900r/min)를 보장하면서 반응을 진행시켰다. 반응과정에 생성되는 HCl기체는 기체유도관을 통하여 뽑아내였다.

적하후에 온도를 150℃까지 올리고 일정한 시간동안 반응시켰다.

반응이 끝나면 진공증류장치를 리용하여 1.05kPa에서 진공증류하여 미반응물, 부생성물을 제거하고 남은 트리스(2,4-디3급부틸페닐)포스피트를 조생성물로 얻었다. 얻은 조생

성물을 이소프로필알콜로 세척하여 미량의 부생성물을 제거하고 흰색의 결정분말로 된 트리스(2,4-디3급부틸페닐)포스피트를 얻었다.

트리스(2,4-디3급부틸페닐)포스피트의 녹음점은 모세관측정법으로, 적외선스펙트르분석은 푸리에변환적외선분광기(《FTIR-8101》)로, 질량스펙트르분석은 초고성능액체크로마토그라프-질량분석기(《SQD-2》)를 리용하여 진행하였다.

실험결과 및 고찰

트리스(2,4-디3급부틸페닐)포스피트의 거둠률에 미치는 유기염기들의 영향 먼저 4종의 유기염기를 선택하고 트리스(2,4-디3급부틸페닐)포스피트의 거둠률에 미치는 유기염기들의 영향을 고찰하였다.(표)

| T. TOTAL TEMESTERS TO THE WAY TO THE TOTAL | | |
|--|-------------|---------|
| No. | 유기염기들 | 거 둠 률/% |
| 1 | 디메틸포름아미드 | 90.5 |
| 2 | 시클로헥실아민 | 84.2 |
| 3 | N,N-디메틸벤질아민 | 77.6 |
| 4 | 피리딘 | 89.4 |

표. 트리스(2,4-디3급부틸페닐)포스피트의 거둠률에 미치는 유기염기들의 영향

2,4-디3급부틸페놀과 삼염화린의 물질량비 3:1.2, 반응온도 150℃, 반응시간 5h, 유기염기의 함량은 2,4-디3급부틸페놀에 대하여 7질량%

표에서 보는바와 같이 4종의 유기염기를 리용하였을 때 트리스(2,4-디3급부틸페닐) 포스피트의 거둠률은 리용한 유기염기에 따라 서로 다르다.

트리스(2,4-디3급부틸페닐)포스피트의 거둠률이 가장 높은 유기염기로는 디메틸포름 아미드이다. 그러므로 트리스(2,4-디3급부틸페닐)포스피트의 합성에서 디메틸포름아미드 를 리용하였다.

반경험적분자궤도법(AM1)으로 디메틸포름아미드, 시클로헥실아민, N,N-디메틸벤질아민, 피리딘에서 질소원자의 전자밀도들을 계산한 결과는 그림 1과 같다.

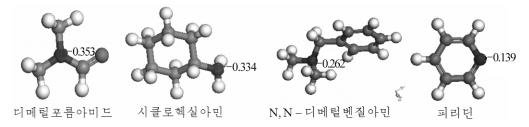


그림 1. 반경험적분자궤도법(AM1)으로 계산한 질소원자의 전자밀도

그림 1에서 보는바와 같이 전자밀도순서를 보면 디메틸포름아미드(0.353) > 시클로 헥실아민(0.334) > N,N-디메틸벤질아민(0.262) > 피리딘(0.139)으로서 디메틸포름아미드가 제일 크다.

유기염기의 종류에 따라 거둠률에서 차이가 생기는 원인을 구체적으로 따져보기 위하여 디메틸포름아미드와 N,N-디메틸벤질아민이 반응물인 2,4-디3급부틸페놀성OH기의 수소원자를 떼여내는 반응에서 과도상태의 공간구조를 최적화하였다. 그리고 이 반응의활성화에네르기를 최신반경험적분자궤도법인 PM7법으로 계산하였다.(그림 2) 계산결과

에 의하면 디메틸포름아미드를 유기염기로 리용한 경우에 탈수소반응의 활성화에네르기는 -0.210~3 kJ/mol이고 N,N-디메틸벤질아민을 리용한 경우에는 97.529kJ/mol이였다. 이것은 디메틸포름아미드를 리용하면 <math>N,N-디메틸벤질아민을 리용한것보다 거둠률이 높아진다는 실험적사실과 잘 맞는다. 이로부터 유기염기의 종류에 따라 거둠률에서 차이가 생기는것은 유기염기의 종류에 따라 반응물의 OH기에서 수소원자를 뗴여내는 능력이 차이나기때문이다.

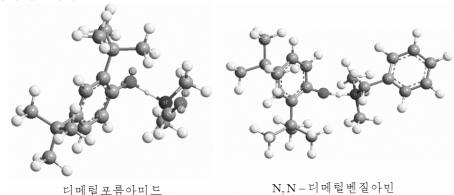


그림 2. 염기의 종류에 따르는 탈수소반응의 과도상태

트리스(2,4-디3급부틸페닐)포스피트의 합성에 미치는 디메틸포름아미드함량의 영향 트리스(2,4-디3급부틸페닐)포스피트의 합성에서 디메틸포름아미드의 함량을 정확히 결정하는것은 매우 중요하다.

선행연구[3]에는 디메틸포름아미드의 함량을 반응에 들어가는 2,4-디3급부틸페놀을 기준으로 하여 3~7질량%라고만 지적되여있다.

반응에 들어가는 디메틸포름아미드의 함량을 정확히 결정하기 위하여 2,4-디3급부틸페놀과 삼염화린의 물질량비 3:1.2, 반응온도 150℃, 반응시간 5h에서 2,4-디3급부틸페놀에 대하여 디메틸포름아미드의 함량을 2~9질량%까지 변화시키면서 트리스(2,4-디3급부틸페닐)포스피트의 거둠률을 비교하였다.(그림 3)

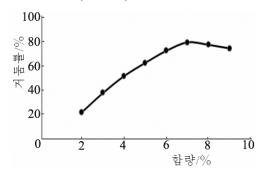


그림 3. 디메틸포름아미드의 함량에 따르는 트리스(2,4-디3급부틸페닐)포스피트의 거둠률변화

그림 3에서 보는바와 같이 트리스(2,4-디3급부틸페닐)포스피트의 거둠률은 디메틸 포름아미드의 함량이 많아짐에 따라 증가하다가 7질량%에서 최대로 되며 그 이상에서 는 거의 변화가 없었다. 따라서 합리적인 디메틸포름아미드의 함량은 7질량%라는것을 알 수 있다.

맺 는 말

- 1) 트리스(2,4-디3급부틸페닐)포스피트의 거둠률이 가장 높은 유기염기로는 디메틸포름아미드이다.
- 2) 트리스(2,4-디3급부틸페닐)포스피트의 합성에서 거둠률을 최대로 높일수 있는 디메틸포름아미드의 함량은 2.4-디3급부틸페놀에 대하여 7질량%이다.

참 고 문 헌

- [1] 赵芸 等; 应用化学, 20, 1, 382, 2003.
- [2] 翠芳 等; 兰化科技, 10, 2, 99, 1992.
- [3] 王军 等; 山东化工, 45, 10, 20, 2016.

주체109(2020)년 4월 5일 원고접수

Effect of Some Organic Bases on the Synthesis of Tris(2,4-di-tert-Butylphenyl)Phosphite

Ri Sang Ryong, Maeng Thae Won and Kim Yong Mi

Organic base capable of increasing the yield of tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite is dimethylformamide.

When the content of dimethylformamide is 7wt% of 2,4-di-tert-butylphenol, the yield of tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite is the highest.

Keywords: tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite, organic base